

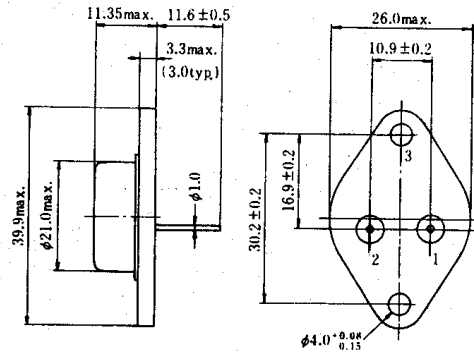
2SC3658, 2SC3659

シリコン NPN 三重拡散形

高電圧, 大電力スイッチング用

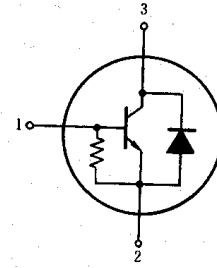
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

HIGH VOLTAGE, HIGH POWER SWITCHING



(JEDEC TO-3)

1. ベース: Base
 2. エミッタ: Emitter
 3. コレクタ: Collector
(ケース) (Case)
- (Dimensions in mm)



■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

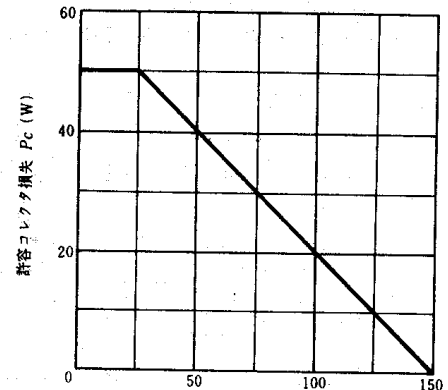
| 項目 | Symbol | 2SC3658 | 2SC3659 | Unit |
|-------------|---------------|----------|----------|------------------|
| コレクタ・エミッタ電圧 | V_{CES} | 1500 | 1700 | V |
| エミッタ・ベース電圧 | V_{EBO} | 6 | 6 | V |
| コレクタ電流 | I_D | 5 | 5 | A |
| せん頭コレクタ電流 | $i_{C(peak)}$ | 6 | 6 | A |
| ダイオード順方向電流 | I_D | 6 | 6 | A |
| 許容コレクタ損失 | P_C^* | 50 | 50 | W |
| 接合部温度 | T_j | 150 | 150 | $^\circ\text{C}$ |
| 保存温度 | T_{stg} | -45~+150 | -45~+150 | $^\circ\text{C}$ |

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化

MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



ケース温度 T_c ($^\circ\text{C}$)

■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

| 項目 | Symbol | Test Condition | 2SC3658 | | | 2SC3659 | | | Unit |
|------------------|---------------|--|---------|------|------|---------|------|------|---------------|
| | | | min. | typ. | max. | min. | typ. | max. | |
| コレクタ遮断電流 | I_{CBO} | $V_{CB}=1200\text{V}, I_E=0$ | — | — | 500 | — | — | — | μA |
| | | $V_{CB}=1400\text{V}, I_E=0$ | — | — | — | — | — | 500 | μA |
| エミッタ遮断電流 | I_{EBO} | $V_{EB}=6\text{V}, I_C=0$ | — | — | 500 | — | — | 500 | mA |
| コレクタ・エミッタ飽和電圧 | $V_{CE(sat)}$ | $I_C=5\text{A}, I_B=1.25\text{A}^*$ | — | — | 2.0 | — | — | 2.0 | V |
| ベース・エミッタ飽和電圧 | $V_{BE(sat)}$ | $I_C=5\text{A}, I_B=1.25\text{A}^*$ | — | — | 1.5 | — | — | 1.5 | V |
| エミッタ・コレクタダイオード電圧 | V_{ECF} | $I_F=6\text{A}^*$ | — | — | 2.0 | — | — | 2.0 | V |
| 下降時間 | t_f | $I_C=5\text{A}, I_B=1\text{A}, I_{B2}=-2.5\text{A}, L_B=0$ | — | — | 0.5 | — | — | 0.5 | μs |

* ハルス測定

* Pulse Test